Виктор Жданкин

# Принципиальная схема ИВЭП серии NLP65

### Вопрос

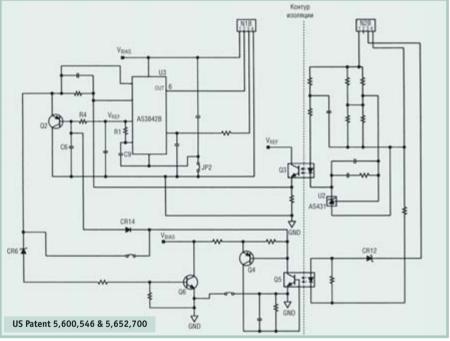
В статье «Импульсные АС/DC-преобразователи фирмы Artesyn Technologies®», опубликованной в журнале «СТА» № 1 за 2003 год, упоминается о схемотехнических решениях, реализованных в ИВЭП серии NLP. Существует ли возможность ознакомиться с принципиальными схемами конкретных источников данной серии?

### **OTRET**

После согласования некоторых вопросов с фирмой-изготовителем появилась возможность опубликовать на страницах журнала «СТА» принципиальные схемы ИВЭП серии NLP65 (US Patent 5,600,546 & 5,652,700).

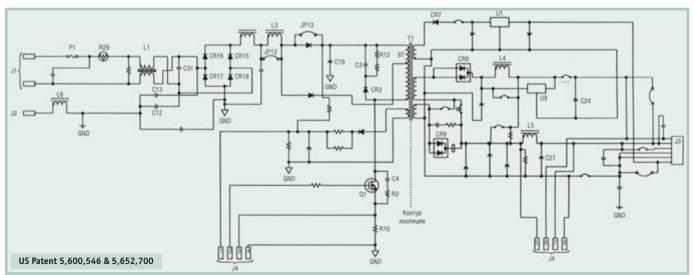
Принципиальная схема платы управления показана на рис. 1, принципиальная схема силовой части источника представлена на рис. 2. Схемотехнически модули ИВЭП серии NLP65 выполнены на основе метода широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с постоянной рабочей частотой, обратной связью по напряжению (voltage mode), а также с дополнительной обратной связью по току дросселя (ДОСТД, или current mode). Такой подход способствует улучшению электрических характеристик и снижению габаритных размеров ИВЭП. Используемая топология IFB-Integrated Boost Flyback (полупроводниковые компоненты Q5, Q4, Q6, CR12, CR14, CR6) увеличивает эффективность преобразования при полной нагрузке: достигается значение удельной мощности  $244 \text{ BT/дм}^3$ . Для реализации управления приме-

Для реализации управления применяется специализированная ИМС U3 однотактного ШИМ-контроллера AS3842B (ASTEC Semiconductor). Разработанная ещё в 1984 году Ларри Уофордом, сотрудником фирмы Unitrode, интегральная микросхема UC3842 (прототип AS3842B) производится в наше время многими фирмами, среди которых Texas Instruments (в



Условные обозначения:  $V_{BIAS}$  — напряжение смещения;  $V_{REF}$  — опорное напряжение; N1B, N2B — межплатные соединители; GND — заземление.

Рис. 1. Принципиальная схема платы управления ИВЭП серии NLP65



Условные обозначения: J1, J2, J3, J4 — соединители; GND — заземление.

Рис. 2. Принципиальная схема силовой части ИВЭП серии NLP65

86

неё входит Unitrode), ST Microelectronics, ON Semiconductor, Teledyne Semiconductor, Motorola, ASTEC Semiconductor и др. Если считать копирование высшей формой признания, то серия UC3842, безусловно, имеет успех. Естественно, серия UC3842 получила развитие в наши дни, например, изготавливаются ИМС по BiCMOS-технологии.

ИМС U3 обеспечивает работу преобразователя напряжения на фиксированной частоте (100 кГц), определяемой параметрами частотозадающей R1С9-цепи. Транзистор Q2, конденсатор C6, резистор R14 образуют схему мягкого запуска. Непосредственное измерение напряжения на выходе осуществляется при помощи популярной специализированной ИМС U2 AS431 (ASTEC Semiconductor), представляющей собой усилитель сигнала рассогласования с внутренним источником опорного напряжения 2,5 В. Подробно ознакомиться с принципом работы и применением так называемого «регулируемого стабилитрона» TL431 можно в [1]. Управляющий сигнал на первичную сторону преобразователя передаётся через оптопару (МОС8103), гальванически разделяющую вход и выход по цепи обратной

Силовой транзистор Q1 (MOSFET IRF840) периодически открывается и закрывается ШИМ-контроллером посредством изменения относительной длительности импульсов на выходе 6 (OUT) ИМС U3. Трансформатор T1 передаёт энергию первичного источника электропитания во вторичные цепи преобразователя. Выходные напряжения трансформатора выпрямляются диодами CR7, CR8, CR9 и передаются на выход. Дроссели L4, L5 и конденсаторы С24, С27 образуют выходные фильтры, подавляющие остаточную переменную составляющую с частотой преобразования. Для стабилизации напряжения на дополнительных каналах применяются ИМС линейных стабилизаторов U1, U9 (например, на выходе NLP65-7608G устанавливаются ИМС 7812 для стабилизации +12 B и ИМС 7912 — для стабилизации напряжения канала -12 B).

Резистор R12, конденсатор C3 и диод CR3 образуют демпфирующую цепочку для ограничения коммутационного импульса напряжения на стоке силового транзистора Q1. Демпфирование импульса, обусловленного на-

личием индуктивности рассеяния обмоток трансформатора, выполняется цепью R3C4, которая обеспечивает безопасное выключение силового транзистора. В конечном счёте обе цепочки создают условия для безопасной работы транзистора Q1.

Резистор R10 является токоизмерительным резистором внутренней петли обратной связи по току.

Терморезистор R29 (10 Ом) с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (Negative Temperature Coefficient — NTC) служит для ограничения тока заряда входного конденсатора C19 (150 мкФ, 400 В), который при включении представляет собой короткозамкнутую цепь. После прохождения пика зарядного тока резистор разогревается, и его сопротивление уменьшается в 20...50 раз. В номинальном режиме работы оно остаётся низким.

Входная цепь ИВЭП представляет собой фильтр, состоящий из дросселя L1 и конденсаторов С31, С12, С13, причём дроссель и конденсатор С31 (Х-конденсатор) подавляют синфазные, а конденсаторы С12 и С13 (Ү-конденсаторы) — несимметричные помехи, возникающие при работе преобразователя. На диодах CR15-CR18 выполнен выпрямитель сетевого напряжения. Предохранитель F1 служит для аварийной защиты в случае выхода из строя какого-либо элемента. В ИВЭП с индексом «G» в маркировке дополнительно устанавливается дроссель L6 (небольшое ферритовое кольцо с пятью-шестью витками медного провода), что обеспечивает ЭМС в соответствии с Level В при использовании неметаллических шасси, в которых невозможно осуществить заземление посредством монтажных винтов.

## Вопрос

Какие элементы схемы ИВЭП обеспечивают коррекцию коэффициента мощности?

# **O**TBET

Патентованная схема пассивного корректора коэффициента мощности (КМ) обеспечивает соответствие требованиям стандарта EN 61000-3-2, устанавливающего пределы интенсивности гармонических составляющих потребляемого тока со второй по сороковую гармоники. Для управления интервалами протекания входного тока в ИВЭП с корректором КМ (рис. 2)

используется дополнительная обмотка первичной обмотки силового трансформатора Т1 (9Т) и дополнительный дроссель L3 (перемычки JP12, JP13 задействуются в моделях без корректора КМ, также выполненных на базе единой унифицированной печатной платы). Ограничение пикового напряжения на накопительном конденсаторе С19 до приемлемого уровня во всём диапазоне входного напряжения (90...264 В переменного тока) обеспечивается соотношением числа витков двух первичных обмоток.

ИВЭП серии NLP65 имеют значение коэффициента мощности около 0,75. ●

### Литература

1. Хвастин С. Обратная связь в многоканальных импульсных обратноходовых преобразователях напряжения// Схемотехника. — 2002. — № 5.

В.К. Жданкин — сотрудник фирмы ПРОСОФТ 119313 Москва, а/я 81 Телефон: (095) 234-0636 Факс: (095) 234-0640 E-mail: victor@prosoft.ru

87